

平成 30 年 6 月 11 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 柿本 浩一

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 159 回研究会 開催通知

テーマ：「Si の結晶成長、Grown-in 欠陥と欠陥評価」

日時：2018 年 7 月 13 日（金）13:00～17:35

会場：明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン A1 会議室

世話人：柿本 浩一（九州大学）、末岡 浩治（岡山県立大学）、佐俣 秀一（SUMCO）、
泉妻 宏治（グローバルウェーブ・ジャパン）

プログラム

13:00～13:05 開会の挨拶 九州大学 柿本 浩一

13:05～13:10 はじめに SUMCO 佐俣 秀一

[1] 結晶成長

13:10～13:50 「結晶成長における軽元素制御」

九州大学 柿本 浩一

13:50～14:30 「横磁場 MCZ Si 単結晶成長プロセスの全炉内 3 次元熱・物質輸送解析」

SUMCO 横山 竜介

14:30～15:10 「結晶成長時の炭素濃度制御とライフタイムへの影響」

GWJ 永井 勇太

15:10～15:30 休憩

[2] Grown-in 欠陥

15:30～16:10 「Si 結晶成長中の点欠陥挙動に与えるドーパントと熱応力の影響」

岡山県立大学 末岡 浩治

[3] 欠陥評価

16:10～16:50 「欠陥評価：セミラボにおける結晶欠陥測定技術の紹介」

日本セミラボ 杉田 宗幸

16:50～17:30 「赤外トモ／TEM による BMD 実態解析」

GWJ 須藤 治生

17:30～17:35 おわりに

GWJ 泉妻 宏治

18:00～20:00 意見交換会（明治大学 リバティータワー23階 サロン燦）

以上